



Javier Miguel Sánchez nació en 1978 en Madrid, pero ha vivido desde entonces en Leganés. En 2001 obtuvo el título de Ingeniero de Telecomunicación y en 2005 la Licenciatura de Ciencias Físicas. A principios del 2006 defendió su tesis doctoral obteniendo la calificación de Sobresaliente *cum laude*, con la mención de *Doctor Europeus*, por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha sido becario del Ministerio de Educación durante los estudios de grado, becario de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y

becario y contratado con el programa de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio. Tras terminar la tesis doctoral ha sido profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica (Laboratorio de Sistemas Digitales, Nanoingeniería para la Información y las Comunicaciones) (www.die.upm.es), en el grupo de electrónica de alta velocidad e investigador del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (www.isom.upm.es), y actualmente es ingeniero de proceso de semiconductores III-V en la empresa Isofotón (www.isofoton.com) y colabora con el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC.

Javier ha trabajado en diferentes proyectos europeos y nacionales de investigación (GINA1.5, KorriGaN, Nanocomic, etc.) y ha realizado tres estancias en el *Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik* de Berlín y en la universidad de Sheffield. Desde el año 2000 trabaja como voluntario de Ingeniería sin Fronteras (www.isf.es). Es autor o coautor de más de 30 publicaciones científicas internacionales (revisadas por pares), otras tantas contribuciones a congresos nacionales e internacionales, editor de un libro internacional (en preparación), autor de 3 capítulos en libros internacionales y de 2 nacionales, y revisor de *J. Appl. Phys.*, *Appl. Phys. Lett.*, *IEEE Photon. Techn. Lett.*, entre otras.

Ha trabajado en diferentes temas científico-tecnológicos, siempre entre la ingeniería electrónica y la física, con interés en la nanotecnología: Caracterización de dispositivos cuánticos de detección de infrarrojo, crecimiento epitaxial por haces moleculares (MBE) y en fase vapor por organometálicos (OMVPE o MOCVD) de semiconductores III-V, caracterización óptica y estructural de materiales optoelectrónicos y dispositivos LED y láser basados en pozos y puntos cuánticos, caracterización eléctrica de transistores basados en nitruros III-N, y actualmente cálculos ab-initio para el estudio de nanoroteros sobre superficies y el crecimiento epitaxial y caracterización de células solares de alto rendimiento.